

2SC3150 (3DD3150)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于开关电源。

Purpose: Switching regulator applications.

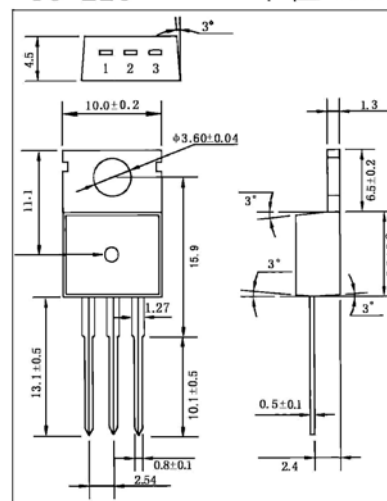
特点:击穿电压高, 开关速度快, 宽阔的安全区。

Features: High V_{CE0} , high speed switching, wide ASO.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	900	V
V_{CE0}	800	V
V_{EB0}	7.0	V
I_C	3.0	A
I_{CP}	10	A
I_B	1.5	A
P_C	2.0	W
$P_C(T_c=25^\circ\text{C})$	50	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

T0-220 单位: mm



引脚: 1 B 2 C 3 E

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=1.0\text{mA}$	$I_E=0$	900			V
V_{CE0}	$I_C=5.0\text{mA}$	$I_B=0$	800			V
V_{EB0}	$I_E=1.0\text{mA}$	$I_C=0$	7.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=800\text{V}$	$I_E=0$			10	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=5.0\text{V}$	$I_C=0$			10	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=0.2\text{A}$	10		40	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=0.5\text{A}$	8			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.5\text{A}$	$I_B=0.3\text{A}$			2.0	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=1.5\text{A}$	$I_B=0.3\text{A}$			1.5	V
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$	$I_C=0.2\text{A}$		15		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$f=1.0\text{MHz}$		60		pF
t_{on}	$5I_{B1}=-2.5I_{B2}=I_C=2.0\text{A}$ $R_L=200\Omega, V_{CC}=400\text{V}$				1.0	μS
t_{stg}					3.0	μS
t_{off}					0.7	μS

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: K:10~20 L:15~30 M:20~40

深圳市盛名达科技有限公司

Shenzhen ShenMingDa Technology CO.,LTD.